



请注意赛普拉斯已正式并入英飞凌科技公司。

此封面页之后的文件标注有“赛普拉斯”的文件即该产品为此公司最初开发的。请注意作为英飞凌产品组合的部分,英飞凌将继续为新的及现有客户提供该产品。

文件内容的连续性

事实是英飞凌提供如下产品作为英飞凌产品组合的部分不会带来对于此文件的任何变更。未来的变更将在恰当的时候发生,且任何变更将在历史页面记录。

订购零件编号的连续性

英飞凌继续支持现有零件编号的使用。下单时请继续使用数据表中的订购零件编号。

带纠错码 (ECC) 的 16 Mbit (1 M 字 × 16 位 / 2 M 字 × 8 位) 静态 RAM

特性

- 超低待机电流
 - 典型待机电流: 5.5 μA
 - 最大待机电流: 16 μA
- 高速度: 45 ns / 55 ns
- 用于单比特错误纠正的嵌入式纠错码 (ECC)
- 工作电压范围广: 1.65 V 至 2.2 V, 2.2 V 至 3.6 V, 4.5 V 至 5.5 V
- 数据保持电压: 1.0 V
- 输入和输出兼容晶体管逻辑 (TTL)
- 错误指示 (ERR) 引脚用于表示单位错误的检测和纠正
- 48 pin TSOP I 封装可被配置为 1 M × 16 或 2 M × 8 SRAM 结构
- 适用于无铅的 48 ball VFBGA 和 48 pin TSOP I 封装

功能描述

CY62167G 和 CY62167GE 是带嵌入式 ECC^[1] 的高性能 CMOS 低功耗 (MoBL®) SRAM 器件。这两种器件均支持单芯片和双芯片使能选项以及多种引脚配置。CY62167GE 器件具有一个 ERR 引脚, 用于通知读周期中的单比特错误检测和纠正事件。

通过将芯片使能输入 (\overline{CE}) 置为低电平, 可以访问单芯片使能的器件。通过将两个芯片使能输入 — \overline{CE}_1 置为低电平, \overline{CE}_2 置为高电平, 可以访问双芯片使能器件。

通过将写入使能输入 (\overline{WE}) 置为低电平, 并分别在器件数据 (I/O₀ 到 I/O₁₅) 引脚和地址 (A₀ 到 A₁₉) 引脚提供数据和地址, 可以执行数据写入操作。字节高电平使能 (BHE) 和字节低电平使能 (BLE) 输入用于控制字节写入操作, 并将相应 I/O 线上的数据写入到指定的存储器位置内。BHE 控制 I/O₈ 到 I/O₁₅; BLE 控制 I/O₀ 到 I/O₇。

通过设置输出使能 (\overline{OE}) 输入, 并提供地址线上所需的地址, 可以执行读取数据的操作。可在 I/O 线 (I/O₀ 到 I/O₁₅) 上读取数据。通过设置所需的字节使能信号 (BHE 或 BLE), 可以执行字节访问, 即读取指定地址上高字节或低字节数据。

当取消选择器件 (单芯片使能器件中 \overline{CE} 为高电平; 双芯片使能器件中 \overline{CE}_1 为高电平 / \overline{CE}_2 为低电平), 或者取消置位控制信号 (\overline{OE} 、BLE、BHE) 时, 会使所有的 I/O (I/O₀ 到 I/O₁₅) 进入高电阻状态。

这些器件还具有独特的“字节断电”性能。具体表现为, 如果字节使能 (BHE 和 BLE) 均被禁用, 不管芯片使能的状态如何, 器件都会无缝切换到待机模式, 从而节省电源消耗。

在 CY62167GE 器件上, 通过 ERR 输出的激活 (ERR 为高电平), 可以指示访问位置中单比特错误的检测和校正。请参考第 16 页上的真值表 — CY62167G/CY62167GE, 了解读写模式的完整说明。

CY62167G 和 CY62167GE 器件适用于无铅的 48 pin TSOP I 封装和 48 ball VFBGA 封装。逻辑框图位于第二页。

可对 48 pin TSOP I 封装中的器件进行配置, 将其作为 2 M 字 × 8 位器件使用。更多详细信息, 请参考“引脚配置”部分。

要获取相关文档的完整列表, 请单击[此处](#)。

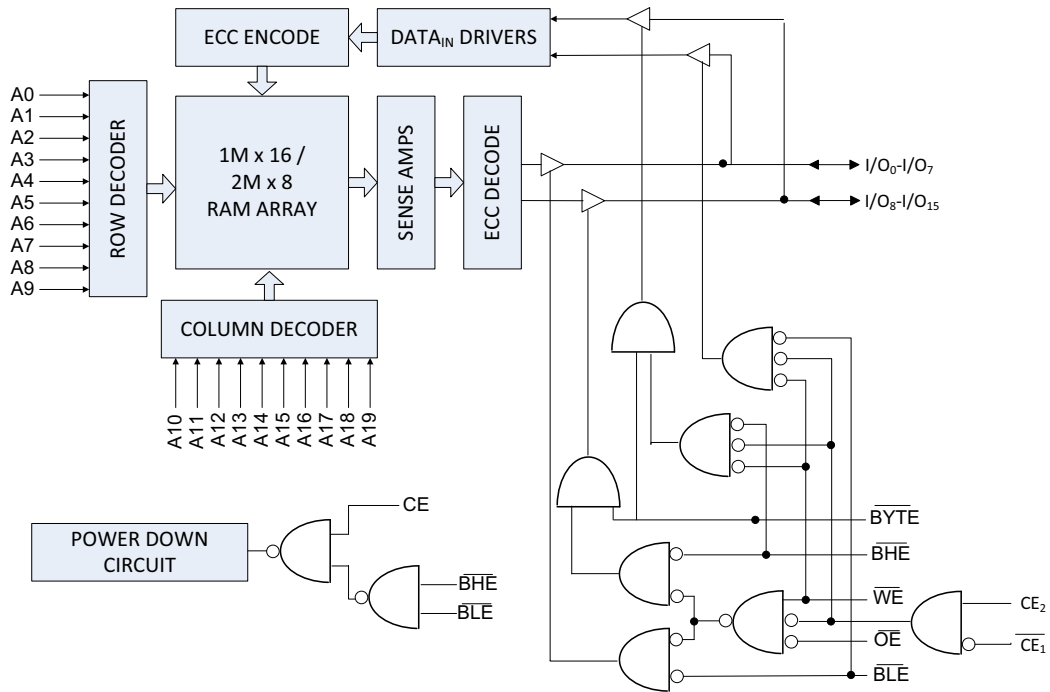
产品系列概述

产品	功能和选项 (请参考“引脚配置” 部分)	范围	V _{CC} 范围 (V)	速度 (ns)	电流消耗			
					工作电流 I _{CC} , (mA)		待机电流 I _{SB2} (μA)	
					f = f _{max}			
					典型值 ^[2]	最大值	典型值 ^[2]	最大值
CY62167G(E)18	单芯片或双芯片使能 可选 ERR 引脚	工业级	1.65 V 至 2.2 V	55	29	32	7	26
CY62167G(E)30 ^[3,4]			2.2 V 至 3.6 V	45	29	36	5.5	16
CY62167G(E)			4.5 V 至 5.5 V					

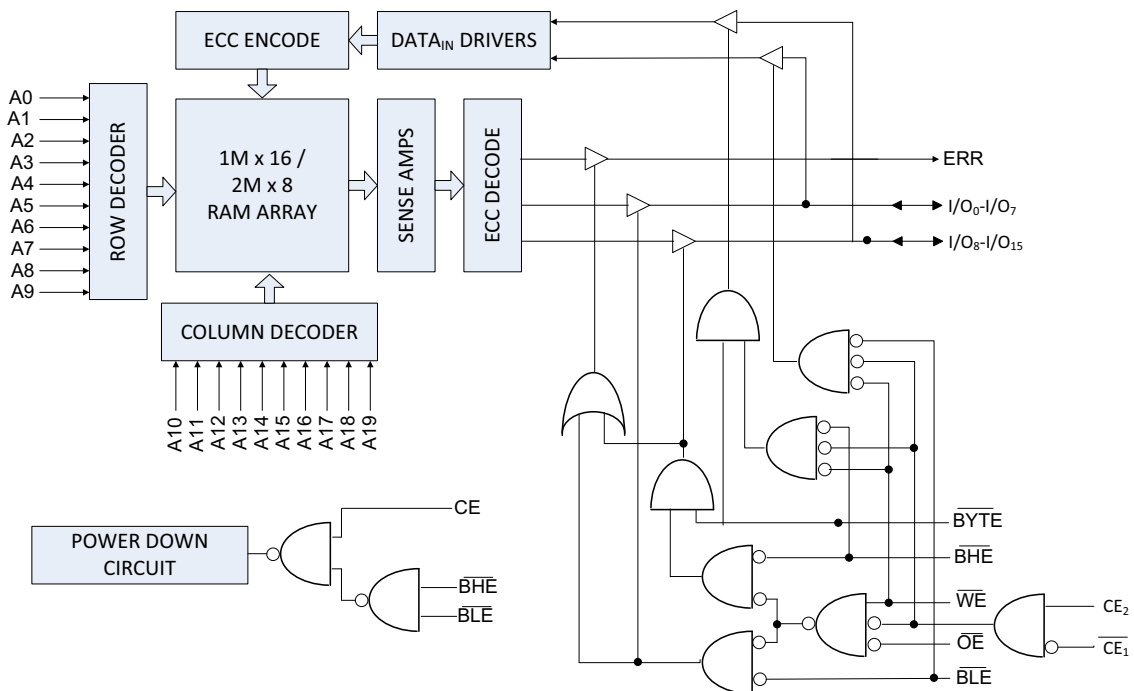
注释:

1. 检测到错误时, 该器件不支持自动回写功能。
2. 典型值仅供参考, 并未得以保证, 也未经过测试。典型值的测量条件为: V_{CC} = 1.8 V (V_{CC} 范围为 1.65 V 至 2.2 V), V_{CC} = 3 V (V_{CC} 范围为 2.2 V 至 3.6 V), V_{CC} = 5 V (V_{CC} 范围为 4.5 V 至 5.5 V), T_A = 25 °C。
3. 3V 典型 V_{CC} 器件使用了改进的 I_{CC}, I_{SB1} 和 I_{SB2} 规格, 相比而言, 当前版本具有相同的营销部件号。新的器件将从 WW1952 开始生产。欲了解更多信息, 请联系赛普拉斯销售代表。
4. 有关此 3V 典型 V_{CC} 器件的下一版本信息, 请参考[这里](#)。有关当前版本和新版本之间的改进和对比的更多详细信息, 请参见 PCN193805。

逻辑框图 — CY62167G

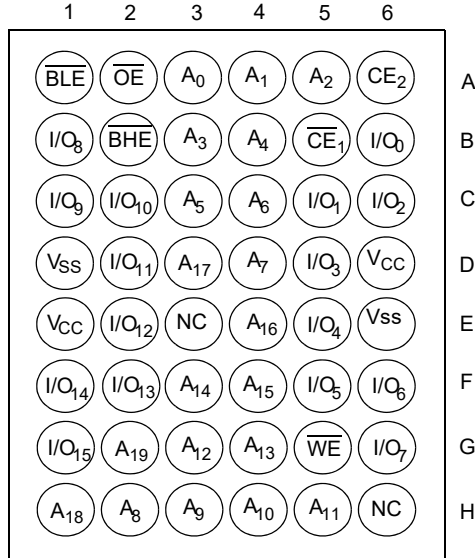
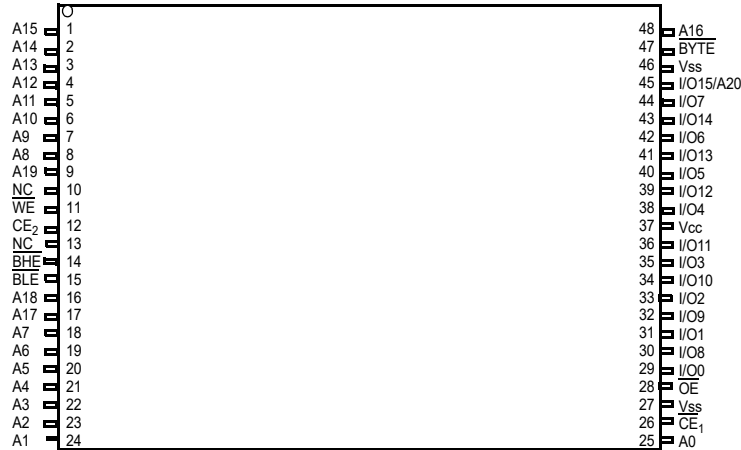


逻辑框图 — CY62167GE



目录

引脚配置 — CY62167G	4	订购信息	17
引脚配置 — CY62167GE	5	订购代码定义	18
最大额定值	7	封装图	19
工作范围	7	缩略语	21
直流电气特性	7	文档规范	21
电容	9	测量单位	21
热阻	9	文档修订记录页	22
交流测试负载和波形	9	销售、解决方案和法律信息	23
数据保持特性	10	全球销售和 design 支持	23
数据保持波形	10	产品	23
切换特性	11	PSoC [®] 解决方案	23
开关波形	12	赛普拉斯开发者社区	23
真值表 — CY62167G/CY62167GE	16	技术支持	23
ERR 输出 — CY62167GE	16		

引脚配置 — CY62167G
图 1. 48 ball VFBGA 引脚分布 (双芯片使能, 不带 ERR) — CY62167G [5]

图 2. 48 pin TSOP I 引脚配置 (不带 ERR 的双芯片使能) — CY62167G [5, 6]

注释:

- NC 引脚没有与裸片 (die) 内部连接, 而通常用于更高容量器件中的地址扩展。更多有关引脚配置的信息, 请参阅各自的数据手册。
- 将 48 pin TSOP I 封装的 **BYTE** 引脚连接到 V_{CC} , 以将该器件作为一个 $1\text{ M} \times 16$ SRAM 使用。通过将 **BYTE** 信号连接到 V_{SS} , 可以将 48 pin TSOP I 封装作为 $2\text{ M} \times 8$ SRAM 使用。在 $2\text{ M} \times 8$ 配置中, 第 45 个引脚是一个额外的地址行 **A20**, 并且不使用 **BHE**、**BLE** 和 **IO₈** 到 **IO₁₄** 引脚, 它们都处于悬空状态。

引脚配置 — CY62167GE

图 3. 48 ball VFBGA 引脚分布 (单芯片使能, 带 ERR) — CY62167GE [7, 8]

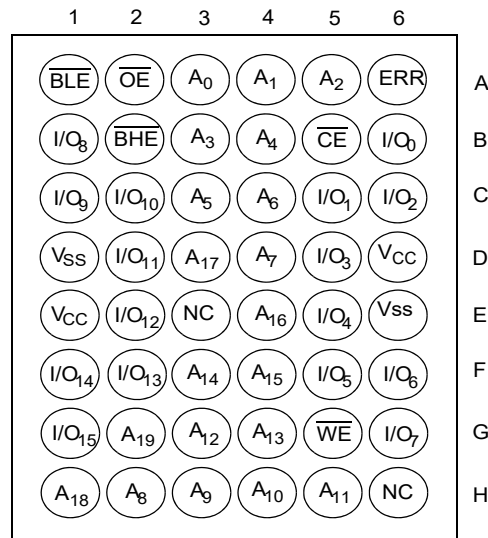
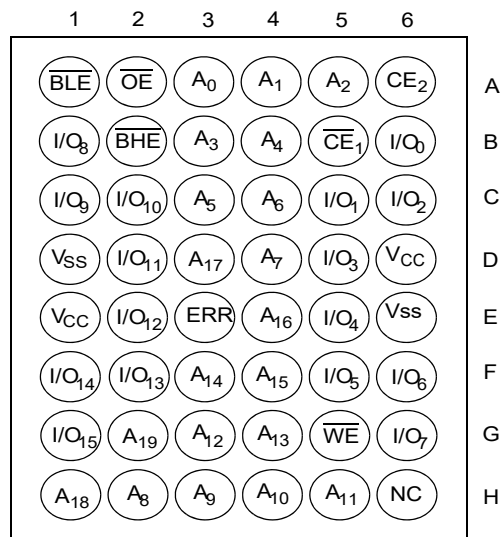
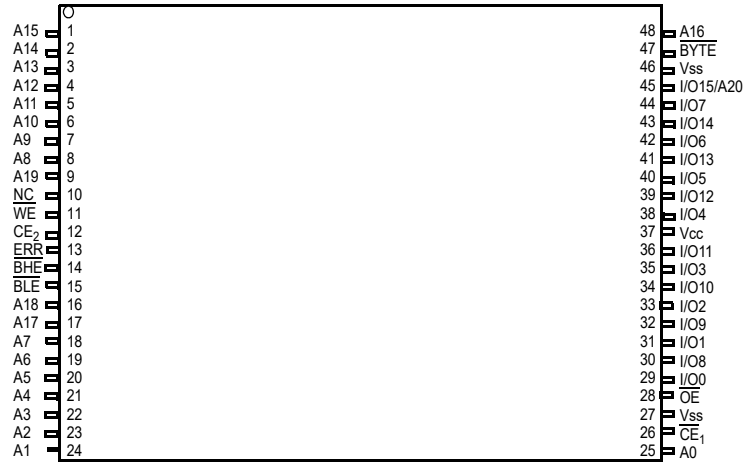


图 4. 48 ball VFBGA 引脚分布 (双芯片使能, 带 ERR) — CY62167GE [7, 8]



注释:

- 7. NC 引脚没有与 Die 内部连接, 而通常用于地址扩展, 从而形成容量更大的器件。有关引脚配置的信息, 请参考相关的数据手册。
- 8. ERR 是一个输出引脚。如果不被使用, 这些引脚应该悬空。

引脚配置 — CY62167GE (续)
图 5. 48 pin TSOP I 引脚分布 (带 ERR 的双芯片使能) — CY62167GE [9, 10]

注释:

9. NC 引脚没有与裸片 (die) 内部连接, 而通常用于更高容量器件中的地址扩展。有关引脚配置的信息, 请参考相关的数据手册。

10. 将 48 pin TSOP I 封装的 BYTE 引脚连接到 V_{CC} , 以将该器件作为一个 $1\text{M} \times 16$ SRAM 使用。通过将 BYTE 信号连接到 V_{SS} , 可以将 48 pin TSOP I 封装作为 $2\text{M} \times 8$ SRAM 使用。在 $2\text{M} \times 8$ 配置中, 第 45 个引脚是一个额外的地址行 A_{20} , 并且不使用 BHE、BLE 和 I/O_8 到 I/O_{14} 引脚, 它们都处于悬空状态。

最大额定值

超过最大额定值可能会缩短器件的使用寿命。用户指导未经过测试。

存放温度	-65 °C ~ +150 °C
通电状态下的环境温度	-55 °C ~ +125 °C
对地电压范围	-0.5 V 至 $V_{CC} + 0.5 V$
应用于高阻状态下的输出的 直流电压 ^[11]	-0.5 V 至 $V_{CC} + 0.5 V$
直流输入电压 ^[11]	-0.5 V 至 $V_{CC} + 0.5 V$

输出电流到输出 (低电平)	20 mA
静电放电电压 (MIL-STD-883, M. 3015)	> 2001 V
栓锁电流	> 140 mA

工作范围

范围	环境温度	V_{CC} ^[12]
工业级	-40°C 到 +85°C	1.65 V 至 2.2 V、 2.2 V 至 3.6 V ^[15, 16] 、 4.5 V 至 5.5 V

直流电气特性

工作温度范围为 -40 °C 至 85 °C

参数	说明	测试条件	45/55 ns			单位	
			最小值	典型值 ^[13]	最大值		
V_{OH}	输出高电平电压	1.65 V 至 2.2 V	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OH} = -0.1 \text{ mA}$	1.4	-	-	V
		2.2 V 至 2.7 V ^[15, 16]	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OH} = -0.1 \text{ mA}$	2.0	-	-	
		2.7 V 至 3.6 V ^[15, 16]	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OH} = -1.0 \text{ mA}$	2.4	-	-	
		4.5 V 至 5.5 V	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OH} = -1.0 \text{ mA}$	2.4	-	-	
		4.5 V 至 5.5 V	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OH} = -0.1 \text{ mA}$	$V_{CC} - 0.4$ ^[14]	-	-	
V_{OL}	输出低电平电压	1.65 V 至 2.2 V	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OL} = 0.1 \text{ mA}$	-	-	0.2	
		2.2 V 至 2.7 V ^[15, 16]	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OL} = 0.1 \text{ mA}$	-	-	0.4	
		2.7 V 至 3.6 V ^[15, 16]	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OL} = 2.1 \text{ mA}$	-	-	0.4	
		4.5 V 至 5.5 V	$V_{CC} = \text{最小值}, I_{OL} = 2.1 \text{ mA}$	-	-	0.4	
V_{IH}	输入高电平电压 ^[11]	1.65 V 至 2.2 V	-	1.4	-	$V_{CC} + 0.2$	
		2.2 V 至 2.7 V ^[15, 16]	-	1.8	-	$V_{CC} + 0.3$	
		2.7 V 到 3.6 V ^[15, 16]	-	2.0	-	$V_{CC} + 0.3$	
		4.5 V 到 5.5 V	-	2.2	-	$V_{CC} + 0.5$	
V_{IL}	输入低电平电压 ^[11]	1.65 V 至 2.2 V	-	-0.2	-	0.4	
		2.2 V 至 2.7 V ^[15, 16]	-	-0.3	-	0.6	
		2.7 V 至 3.6 V ^[15, 16]	-	-0.3	-	0.8	
		4.5 V 至 5.5 V	-	-0.5	-	0.8	
I_{IX}	输入漏电流	$GND \leq V_{IN} \leq V_{CC}$	-1.0	-	+1.0	μA	
I_{OZ}	输出漏电流	$GND \leq V_{OUT} \leq V_{CC}$, 输出被禁用	-1.0	-	+1.0		

注释:

- 在脉冲宽度小于 20 ns 时, $V_{IL(\text{min})} = -2.0 \text{ V}$ 和 $V_{IH(\text{max})} = V_{CC} + 2 \text{ V}$ 。
- 完整的器件交流操作假设 0 到 V_{CC} (最小值) 的升降时间为 100 μs , 并 V_{CC} 稳定到其运行价值时需要等待的时间为 200 μs 。
- 在条件为 3.0 V 和 25 °C 下, 指示参数分布中心的值, 并该值尚未完全测试。
- 该参数仅通过设计决定, 但未经过测试。
- 3V 典型 V_{CC} 器件使用了改进的 I_{CC} , I_{SB1} 和 I_{SB2} 规格, 相比而言, 当前版本具有相同的营销部件号。新的器件将从 WW1952 开始生产。欲了解更多信息, 请联系赛普拉斯销售代表。
- 有关此 3V 典型 V_{CC} 器件的下一版本信息, 请参考[这里](#)。有关当前版本和新版本之间的改进和对比的更多详细信息, 请参见 PCN193805。

直流电气特性 (续)

 工作温度范围为 -40°C 至 85°C

参数	说明	测试条件		45/55 ns			单位
				最小值	典型值 ^[13]	最大值	
I_{CC}	V_{CC} 工作供电电流	$V_{CC} = \text{最大值},$ $I_{OUT} = 0 \text{ mA},$ CMOS 电平	$f = 22.22 \text{ MHz}$ (45 ns)	–	29.0	36.0	mA
			$f = 18.18 \text{ MHz}$ (55 ns)	–	29.0	32.0	
			$f = 1 \text{ MHz}$	–	7.0	9.0	
I_{SB1} ^[17]	自动断电 电流 — CMOS 输入 $V_{CC} = 2.2 \text{ V}$ 至 3.6 V ^[18, 19] 和 4.5 V 至 5.5 V	$\overline{CE}_1 \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V}$ 或 $CE_2 \leq 0.2 \text{ V}$ 或 $(\overline{BHE}$ 和 $\overline{BLE}) \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V},$ $V_{IN} \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V}, V_{IN} \leq 0.2 \text{ V},$		–	5.5	16.0	μA
	自动断电 电流 — CMOS 输入 $V_{CC} = 1.65 \text{ V}$ 至 2.2 V		$f = f_{\text{max}}$ (仅地址和数据), $f = 0$ (\overline{OE} , 和 \overline{WE}), $V_{CC} = V_{CC}(\text{最大值})$	–	7.0	26.0	
I_{SB2} ^[17]	自动断电 电流 — CMOS 输入 $V_{CC} = 2.2 \text{ V}$ 至 3.6 V ^[18, 19] 和 4.5 V 至 5.5 V	$\overline{CE}_1 \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V}$ 或 $CE_2 \leq 0.2 \text{ V}$ 或 $(\overline{BHE}$ 和 $\overline{BLE}) \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V},$ $V_{IN} \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V}$ 或 $V_{IN} \leq 0.2 \text{ V},$ $f = 0, V_{CC} = V_{CC}(\text{最大值})$	25°C	–	5.5	6.5 ^[20]	
			40°C	–	6.3	8.0 ^[20]	
			70°C	–	8.4	12.0 ^[20]	
			85°C	–	12.0	16.0	
	自动断电 电流 — CMOS 输入 $V_{CC} = 1.65 \text{ V}$ 至 2.2 V	$\overline{CE}_1 \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V}$ 或 $CE_2 \leq 0.2 \text{ V}$ 或 $(\overline{BHE}$ 和 $\overline{BLE}) \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V},$ $V_{IN} \geq V_{CC} - 0.2 \text{ V}$ 或 $V_{IN} \leq 0.2 \text{ V},$ $f = 0, V_{CC} = V_{CC}(\text{最大值})$	–	7.0	26.0		

注释:

 17. 芯片使能 (\overline{CE}_1 和 CE_2) 和 \overline{BYTE} 必须连接至 CMOS 电平, 以满足 $I_{SB1}/I_{SB2}/I_{CCDR}$ 规范。其他输入可处于悬空状态。

 18. 3V 典型 V_{CC} 器件使用了改进的 I_{CC} , I_{SB1} 和 I_{SB2} 规格, 相比而言, 当前版本具有相同的营销部件号。新的器件将从 WW1952 开始生产。欲了解更多信息, 请联系赛普拉斯销售代表。

 19. 有关此 3V 典型 V_{CC} 器件的下一版本信息, 请参考[这里](#)。有关当前版本和新版本之间的改进和对比的更多详细信息, 请参见 [PCN193805](#)。

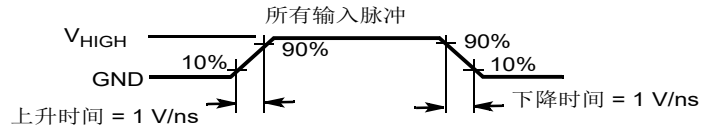
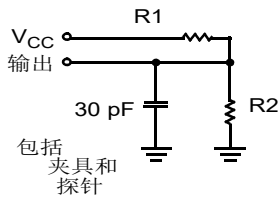
 20. I_{SB2} 的温度限制为 25°C 、 40°C 和 70°C , 这些限制仅通过了设计保证, 尚未完全测试。

电容

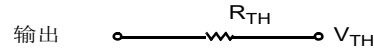
参数 ^[21]	说明	测试条件	最大值	单位
C_{IN}	输入电容	$T_A = 25^\circ\text{C}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{CC} = V_{CC(\text{typ})}$	10.0	pF
C_{OUT}	输出电容		10.0	pF

热阻

参数 ^[21]	说明	测试条件	48 ball VFBGA	48 pin TSOP I	单位
Θ_{JA}	热阻系数 (结至环境)	无气流, 被焊接到 3×4.5 英寸的四层印刷电路板上	31.50	57.99	$^\circ\text{C/W}$
Θ_{JC}	热阻系数 (壳至外壳)		15.75	13.42	$^\circ\text{C/W}$

交流测试负载和波形
图 6. 交流测试负载和波形


根据THÉVENIN定理, 该电路相当于:



参数	1.8 V	2.5 V	3.0 V	5.0 V	单位
R1	13500	16667	1103	1800	Ω
R2	10800	15385	1554	990	Ω
R_{TH}	6000	8000	645	639	Ω
V_{TH}	0.80	1.20	1.75	1.77	V
V_{HIGH}	1.8	2.5	3.0	5.0	V

注释:

21. 在进行可能影响这些参数的任何设计或流程更改之前和之后均进行了测试。

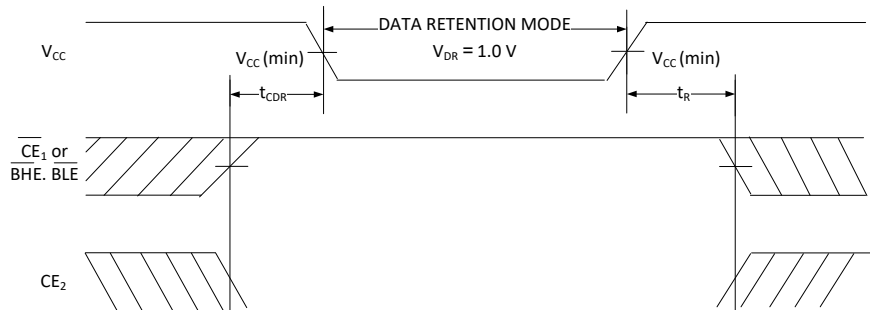
数据保持特性

在工作范围内

参数	说明	条件	最小值	典型值 ^[22]	最大值	单位
V_{DR}	用于数据保持的 V_{CC}	—	1.0	—	—	V
I_{CCDR} ^[23, 24]	数据保持电流	$1.2\text{ V} \leq V_{CC} \leq 2.2\text{ V}$, $\overline{CE}_1 \geq V_{CC} - 0.2\text{ V}$ 或 $CE_2 \leq 0.2\text{ V}$ 或 $(\overline{BHE}$ 和 $\overline{BLE}) \geq V_{CC} - 0.2\text{ V}$, $V_{IN} \geq V_{CC} - 0.2\text{ V}$ 或 $V_{IN} \leq 0.2\text{ V}$	—	7.0	26.0	μA
		$2.2\text{ V} < V_{CC} \leq 3.6\text{ V}$ ^[25, 26] 或 $4.5\text{ V} \leq V_{CC} \leq 5.5\text{ V}$, $\overline{CE}_1 \geq V_{CC} - 0.2\text{ V}$ 或 $CE_2 \leq 0.2\text{ V}$ 或 $(\overline{BHE}$ 和 $\overline{BLE}) \geq V_{CC} - 0.2\text{ V}$, $V_{IN} \geq V_{CC} - 0.2\text{ V}$ 或 $V_{IN} \leq 0.2\text{ V}$	—	5.5	16.0	μA
t_{CDR} ^[27]	芯片取消选择到数据保留的时间	—	0.0	—	—	—
t_R ^[27, 28]	操作恢复的时间	—	45/55	—	—	ns

数据保持波形

图 7. 数据保持波形^[29]



注释:

22. 在条件为 3.0 V 和 25 °C 下, 指示参数分布中心的值, 并该值尚未完全测试。
23. 芯片使能 (\overline{CE}_1 和 CE_2) 和 \overline{BYTE} 必须连接至 CMOS 电平, 以满足 $I_{SB1}/I_{SB2}/I_{CCDR}$ 规范。其他输入可处于悬空状态。
24. 器件首先按 $V_{CC(min)}$ 电压进行加电, 然后再降到 V_{DR} , 这样 I_{CCDR} 才能得到保证。
25. 3V 典型 V_{CC} 器件使用了改进的 I_{CC} , I_{SB1} 和 I_{SB2} 规格, 相比而言, 当前版本具有相同的营销部件号。新的器件将从 WW1952 开始生产。欲了解更多信息, 请联系赛普拉斯销售代表。
26. 有关此 3V 典型 V_{CC} 器件的下一版本信息, 请参考[这里](#)。有关当前版本和新版本之间的改进和对比的更多详细信息, 请参见 [PCN193805](#)。
27. 这些参数由设计保证, 并未经过测试。
28. 为了确保器件正常工作, 线性 V_{CC} 必须在 $\geq 100\ \mu\text{s}$ 的时间内从 V_{DR} 上升到 $V_{CC(min)}$ 或者在 $\geq 100\ \mu\text{s}$ 的时间内保持 $V_{CC(min)}$ 稳定的状态。
29. $\overline{BHE}/\overline{BLE}$ 是通过将 \overline{BHE} 和 \overline{BLE} 进行 “与” 逻辑运算得到的。通过禁用芯片使能信号, 或通过同时禁用 \overline{BHE} 和 \overline{BLE} , 均能取消选择芯片。

切换特性

参数 ^[30]	说明	45 ns		55 ns		单位
		最小值	最大值	最小值	最大值	
读周期						
t_{RC}	读周期的时间	45.0	–	55.0	–	ns
t_{AA}	从寻址到数据有效 / 从寻址到 ERR 有效的的时间	–	45.0	–	55.0	ns
t_{OHA}	地址更改后的数据保持 / ERR 保持时长	10.0	–	10.0	–	ns
t_{ACE}	从 \overline{CE}_1 为低电平和 CE_2 为高电平到数据有效 / \overline{CE} 为低电平到 ERR 有效的的时间	–	45.0	–	55.0	ns
t_{DOE}	从 \overline{OE} 为低电平到数据有效 / \overline{OE} 为低电平到 ERR 有效的的时间	–	22.0	–	25.0	ns
t_{LZOE}	\overline{OE} 为低电平到低阻态的时间 ^[31, 32]	5.0	–	5.0	–	ns
t_{HZOE}	\overline{OE} 为高电平到高阻态的时间 ^[31, 32, 33]	–	18.0	–	18.0	ns
t_{LZCE}	\overline{CE}_1 为低电平和 CE_2 为高电平到低阻态的时间 ^[31, 32]	10.0	–	10.0	–	ns
t_{HZCE}	\overline{CE}_1 为高电平和 CE_2 为低电平到高阻态的时间 ^[31, 32, 33]	–	18.0	–	18.0	ns
t_{PU}	从 \overline{CE}_1 为低电平和 CE_2 为高电平到加电的时间 ^[34]	0.0	–	0.0	–	ns
t_{PD}	从 \overline{CE}_1 为高电平和 CE_2 为低电平到掉电的时间 ^[34]	–	45.0	–	55.0	ns
t_{DBE}	BLE/BHE 为低电平到数据有效的的时间	–	45.0	–	55.0	ns
t_{LZBE}	$\overline{BLE} / \overline{BHE}$ 为低电平到低阻态的时间 ^[31]	5.0	–	5.0	–	ns
t_{HZBE}	$\overline{BLE} / \overline{BHE}$ 为高电平到高阻态的时间 ^[31, 33]	–	18.0	–	18.0	ns
写周期^[35, 36]						
t_{WC}	写周期的时间	45.0	–	55.0	–	ns
t_{SCE}	\overline{CE}_1 为低电平和 CE_2 为高电平到写周期结束的时间	35.0	–	40.0	–	ns
t_{AW}	地址建立到写周期结束的时间	35.0	–	40.0	–	ns
t_{HA}	写周期结束后地址保持的时间	0	–	0	–	ns
t_{SA}	地址设置到写周期开始的时间	0	–	0	–	ns
t_{PWE}	\overline{WE} 脉冲宽度	35.0	–	40.0	–	ns
t_{BW}	$\overline{BLE} / \overline{BHE}$ 为低电平到写周期结束的时间	35.0	–	40.0	–	ns
t_{SD}	从数据建立到写周期结束的时间	25.0	–	25.0	–	ns
t_{HD}	写周期结束后数据保持的时间	0.0	–	0.0	–	ns
t_{HZWE}	\overline{WE} 为低电平到高阻态的时间 ^[31, 32, 33]	–	18.0	–	20.0	ns
t_{LZWE}	\overline{WE} 为高电平到低阻态的时间 ^[31, 32]	10.0	–	10.0	–	ns

注释:

- 假设测试条件如下: 信号跃变时间 (上升 / 下降) 等于或低于 3 ns, 时序参考电平为 1.5 V (对于 $V_{CC} \geq 3 V$) 和 $V_{CC}/2$ (对于 $V_{CC} < 3 V$), 输入脉冲电平范围为 0 至 3 V (对于 $V_{CC} \geq 3 V$) 和 0 至 V_{CC} (对于 $V_{CC} < 3 V$)。除非另有说明, 读周期的测试条件使用第 9 页上的图 6 中所显示的输出加载。
- 在所有温度和电压范围中, 对于所有器件, t_{HZCE} 低于 t_{LZCE} 、 t_{HZBE} 低于 t_{LZBE} 、 t_{HZOE} 低于 t_{LZOE} 以及 t_{HZWE} 低于 t_{LZWE} 。
- 在进行可能影响这些参数的任何设计或流程更改之前和之后均进行了测试。
- t_{HZOE} 、 t_{HZCE} 、 t_{HZBE} 以及 t_{HZWE} 转换的测量条件为输出处于高阻态。
- 这些参数由设计保证, 并未经过测试。
- 通过重叠 $\overline{WE} = V_{IL}$, $\overline{CE}_1 = V_{IL}$, \overline{BHE} 和 / 或 $\overline{BLE} = V_{IL}$ 和 $CE_2 = V_{IH}$, 可以确定存储器的内部写入时间。要想执行某个写操作, 必须使所有信号处于 ACTIVE (活动) 状态; 将任何信号置于 INACTIVE (非活动) 状态都会中止该写操作。终止写入操作的信号边沿作为输入数据建立和保持时序的参考源。
- 第一个写周期 (\overline{WE} 被控制, \overline{OE} 为低电平) 的最小写周期脉冲宽度为 t_{HZWE} 和 t_{SD} 的总和。

开关波形

图 8. CY62167G 的第一个读周期 (地址转换控制) [37, 38]

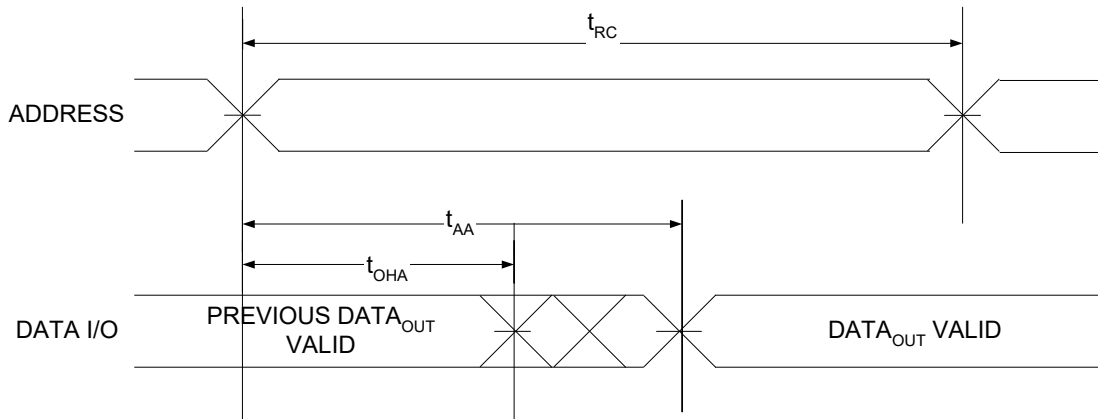
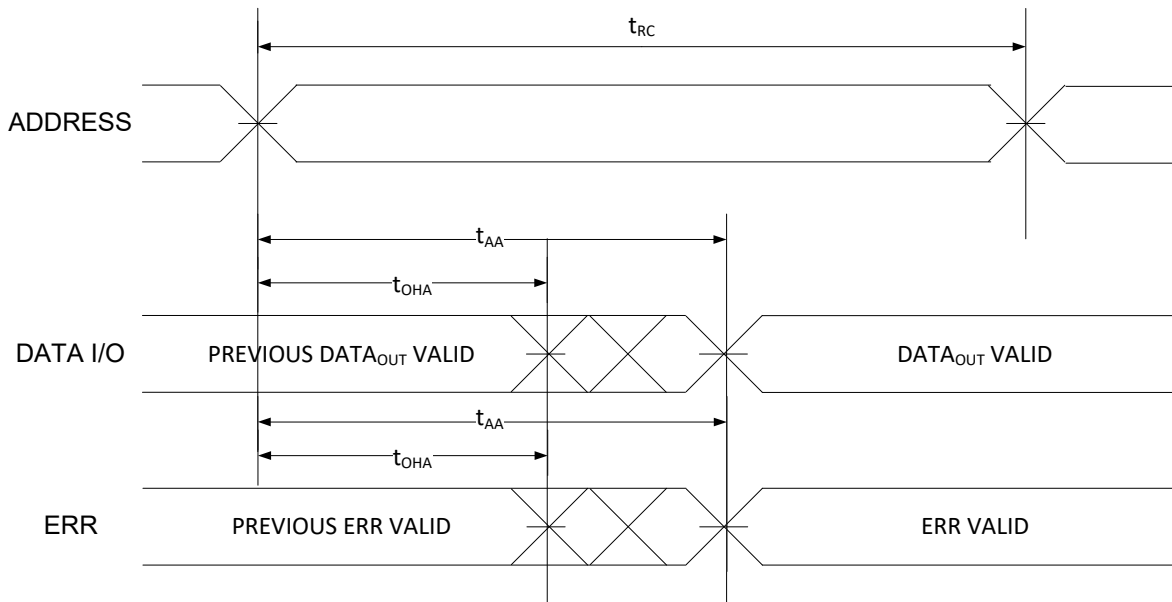


图 9. CY62167GE 的第一个读周期 (地址转换控制) [37, 38]



注释:

37. 器件持续被选择。 $\overline{OE} = V_{IL}$, $\overline{CE} = V_{IL}$, \overline{BHE} 和 / 或 $\overline{BLE} = V_{IL}$ 。

38. 在读周期中, \overline{WE} 为高电平。

开关波形 (续)

图 10. 第二个读周期 (\overline{OE} 控制) [39, 40, 41, 43]

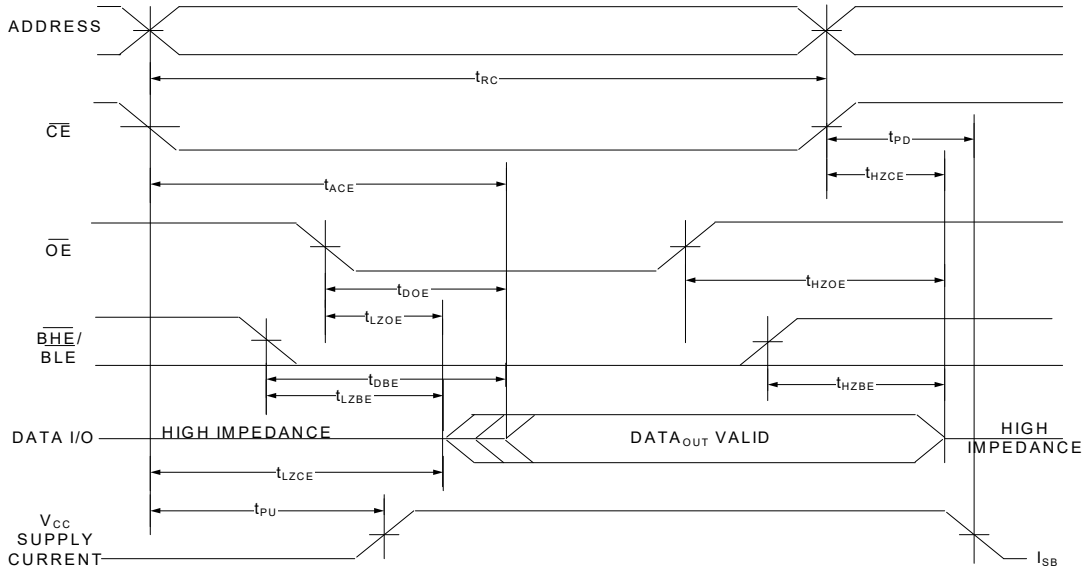
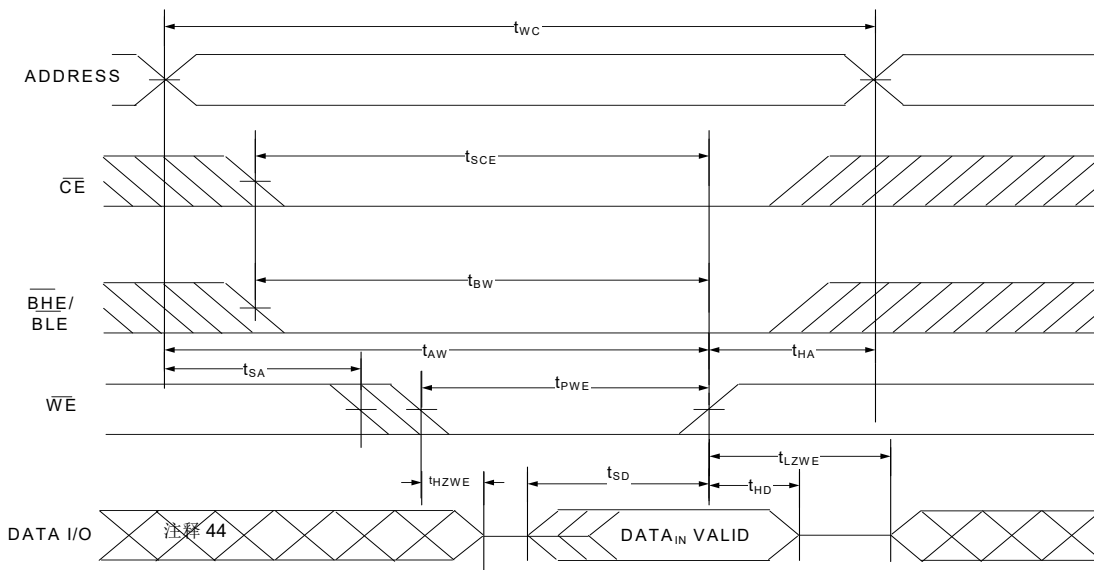


图 11. 第一个写周期 (\overline{WE} 控制、 \overline{OE} 为低电平) [40, 42, 43, 33]

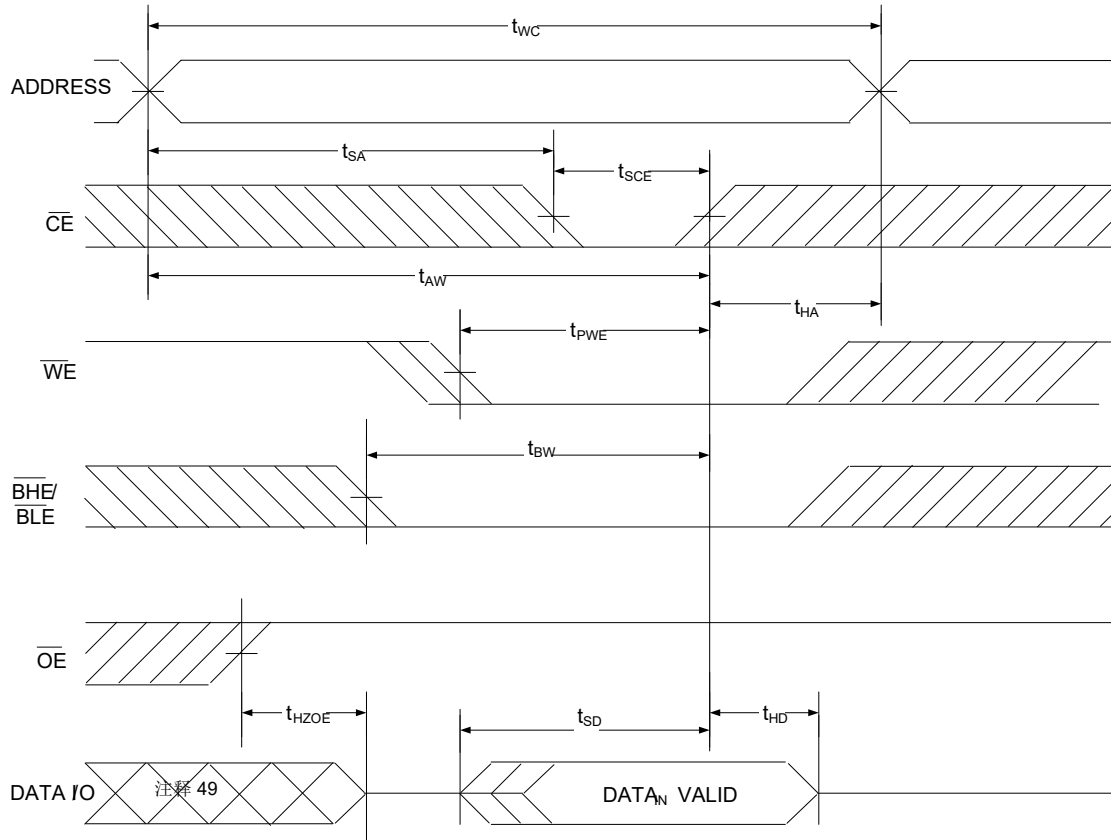


注释:

- 39. 在读周期中, \overline{WE} 为高电平。
- 40. 对于所有的双芯片使能器件, \overline{CE} 由 \overline{CE}_1 和 CE_2 逻辑组合。当 \overline{CE}_1 为低电平, 且 CE_2 为高电平时, \overline{CE} 将处于低电平状态; 当 \overline{CE}_1 为高电平或 CE_2 为低电平时, \overline{CE} 将处于高电平状态。
- 41. 地址有效在 \overline{CE} 的低电平转换前发生或者同步发生。
- 42. 通过重叠 $\overline{WE} = V_{IL}$, $\overline{CE}_1 = V_{IL}$, \overline{BHE} 和 / 或 $\overline{BLE} = V_{IL}$ 和 $CE_2 = V_{IH}$, 可以确定存储器的内部写入时间。要想执行某个写操作, 必须将所有信号置于 ACTIVE (活动) 状态; 将任何信号置于 INACTIVE (非活动) 状态都会中止该写操作。终止写入操作的信号边沿作为输入数据建立和保持时序的参考源。
- 43. 如果 $\overline{CE} = V_{IH}$, 或 $\overline{OE} = V_{IH}$, 或 \overline{BHE} 和 / 或 $\overline{BLE} = V_{IH}$, 数据 I/O 会处于高阻抗状态。
- 44. 在该过程中, I/O 处于输出状态。请勿采用输入信号。
- 45. 最小写周期脉冲宽度应等于 t_{HZWE} 和 t_{SD} 的总和。

开关波形 (续)

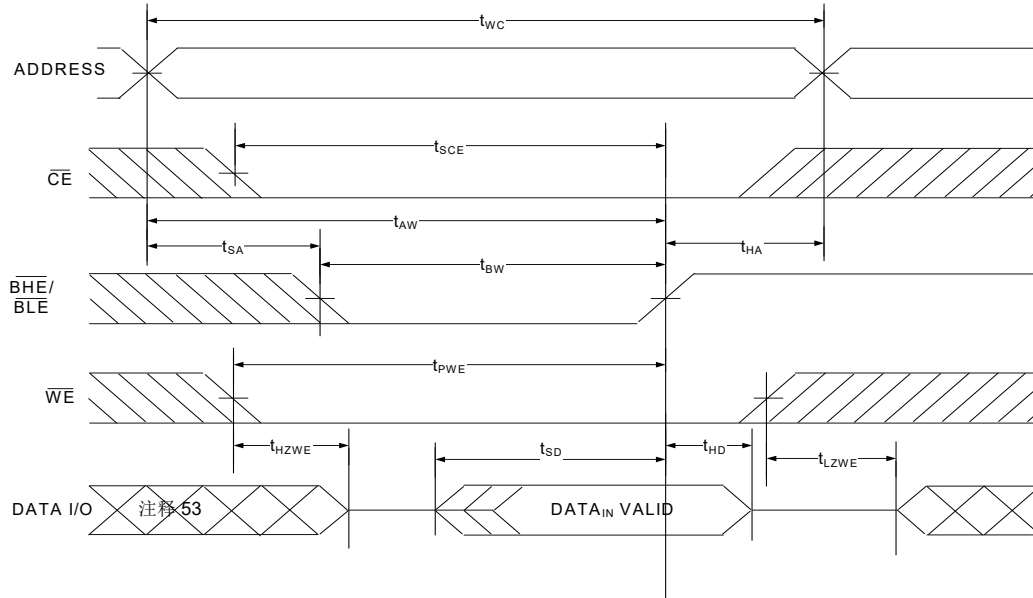
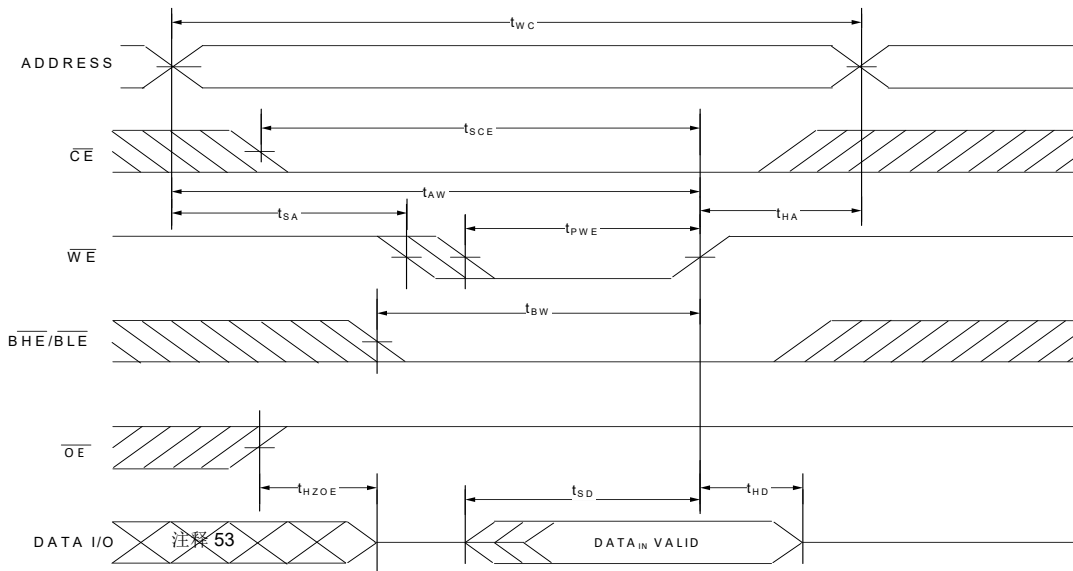
图 12. 第二个写周期 (由 \overline{CE} 控制) [46, 47, 48]



注释:

- 46. 对于所有的双芯片使能器件, \overline{CE} 由 \overline{CE}_1 和 CE_2 逻辑组合。当 \overline{CE}_1 为低电平且 CE_2 为高电平时, \overline{CE} 将处于低电平状态; 当 \overline{CE}_1 为高电平或 CE_2 为低电平时, \overline{CE} 将处于高电平状态。
- 47. 通过重叠 $\overline{WE} = V_{IL}$, $\overline{CE}_1 = V_{IL}$, \overline{BHE} 和 / 或 $\overline{BLE} = V_{IL}$ 和 $CE_2 = V_{IH}$, 可以确定存储器的内部写入时间。要想执行某个写操作, 必须使所有信号处于 ACTIVE (活动) 状态; 将任何信号置于 INACTIVE (非活动) 状态都会中止该写操作。终止写入操作的信号边沿作为输入数据建立和保持时序的参考源。
- 48. 如果 $\overline{CE} = V_{IH}$, 或 $\overline{OE} = V_{IH}$, 或 \overline{BHE} 和 / 或 $\overline{BLE} = V_{IH}$, 数据 I/O 会处于高阻抗状态。
- 49. 在该过程中, I/O 处于输出状态。请勿采用输入信号。

开关波形 (续)

图 13. 第四个写周期 ($\overline{\text{BHE}}/\overline{\text{BLE}}$ 控制、 $\overline{\text{OE}}$ 为低电平) [50, 51, 52]

图 14. 第五个写周期 ($\overline{\text{WE}}$ 控制) [50, 51, 52]

注释:

50. 对于所有的双芯片使能器件, $\overline{\text{CE}}$ 由 $\overline{\text{CE}}_1$ 和 CE_2 逻辑组合。当 $\overline{\text{CE}}_1$ 为低电平且 CE_2 为高电平时, $\overline{\text{CE}}$ 将处于低电平状态; 当 $\overline{\text{CE}}_1$ 为高电平或 CE_2 为低电平时, $\overline{\text{CE}}$ 将处于高电平状态。
51. 通过重叠 $\overline{\text{WE}} = V_{\text{IL}}$, $\overline{\text{CE}}_1 = V_{\text{IL}}$, $\overline{\text{BHE}}$ 和 / 或 $\overline{\text{BLE}} = V_{\text{IL}}$ 和 $\text{CE}_2 = V_{\text{IH}}$, 可以确定存储器的内部写入时间。要想执行某个写操作, 必须使所有信号处于 ACTIVE (活动) 状态; 将任何信号置于 INACTIVE (非活动) 状态都会中止该写操作。终止写入操作的信号边沿作为输入数据建立和保持时序的参考源。
52. 如果 $\overline{\text{CE}} = V_{\text{IH}}$, 或 $\overline{\text{OE}} = V_{\text{IH}}$, 或 $\overline{\text{BHE}}$ 和 / 或 $\overline{\text{BLE}} = V_{\text{IH}}$, 数据 I/O 会处于高阻抗状态。
53. 在该过程中, I/O 处于输出状态。请勿采用输入信号。

真值表 — CY62167G/CY62167GE

BYTE ^[54]	CE ₁	CE ₂	WE	OE	BHE	BLE	输入 / 输出	模式	功耗	配置
X ^[55]	H	X ^[55]	X	X	X	X	高阻态	取消选择 / 断电	待机 (I _{SB})	2 M × 8 / 1 M × 16
X	X ^[55]	L	X	X	X	X	高阻态	取消选择 / 断电	待机 (I _{SB})	2 M × 8 / 1 M × 16
X	X ^[55]	X ^[55]	X	X	H	H	高阻态	取消选择 / 断电	待机 (I _{SB})	1 M × 16
H	L	H	H	L	L	L	数据输出 (I/O ₀ –I/O ₁₅)	读	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	H	L	H	L	数据输出 (I/O ₀ 到 I/O ₇) ; 高阻态 (I/O ₈ 到 I/O ₁₅)	读	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	H	L	L	H	高阻态 (I/O ₀ 到 I/O ₇) ; 数据输出 (I/O ₈ 到 I/O ₁₅)	读	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	H	H	L	H	高阻态	输出处于禁用状态	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	H	H	H	L	高阻态	输出处于禁用状态	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	H	H	L	L	高阻态	输出处于禁用状态	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	L	X	L	L	数据输入 (I/O ₀ –I/O ₁₅)	写入	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	L	X	H	L	数据输入 (I/O ₀ 到 I/O ₇) ; 高阻态 (I/O ₈ 到 I/O ₁₅)	写	活动 (I _{CC})	1 M × 16
H	L	H	L	X	L	H	高阻态 (I/O ₀ 到 I/O ₇) ; 数据输入 (I/O ₈ 到 I/O ₁₅)	写	活动 (I _{CC})	1 M × 16
L	L	H	H	L	X	X	数据输出 (I/O ₀ 到 I/O ₇)	读	活动 (I _{CC})	2 M × 8
L	L	H	H	H	X	X	高阻态	输出处于禁用状态	活动 (I _{CC})	2 M × 8
L	L	H	L	X	X	X	数据输入 (I/O ₀ 到 I/O ₇)	写	活动 (I _{CC})	2 M × 8

ERR 输出 — CY62167GE

输出 ^[56]	模式
0	读操作，存储数据中没有单比特错误。
1	读操作，检测到并纠正了单比特错误。
高阻态	取消选择器件 / 禁用输出 / 写操作

注释:

54. 只有 48 pin TSOP I 封装才有该引脚。通过将 BYTE 连接到 V_{CC}，可以在 1 M × 16 选项中配置该器件。通过将 BYTE 信号连接到 V_{SS}，可以将 48 pin TSOP I 封装作为 2 M × 8 SRAM 使用

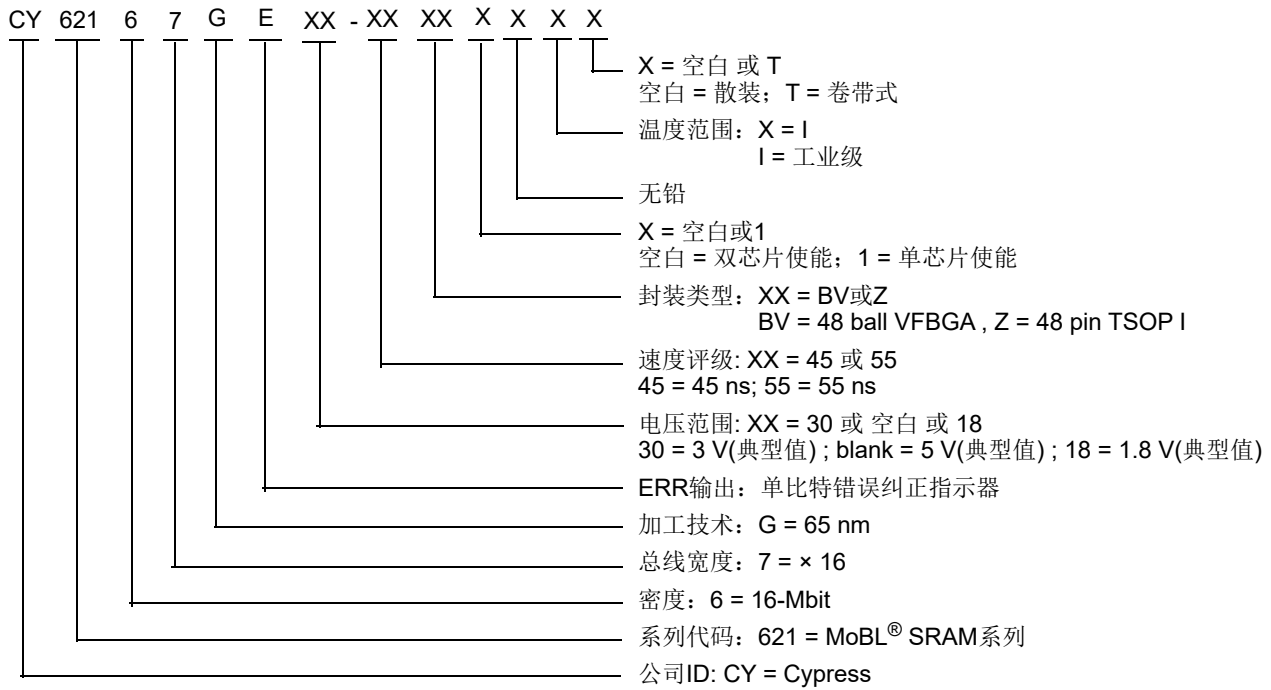
55. 芯片使能的 ‘X’ (无需关注) 状态指的是信号的逻辑状态 (高电平或低电平)。这些引脚不支持中间电压电平。

56. ERR 是一个输出引脚。如果不被使用，这些引脚应该悬空。

订购信息

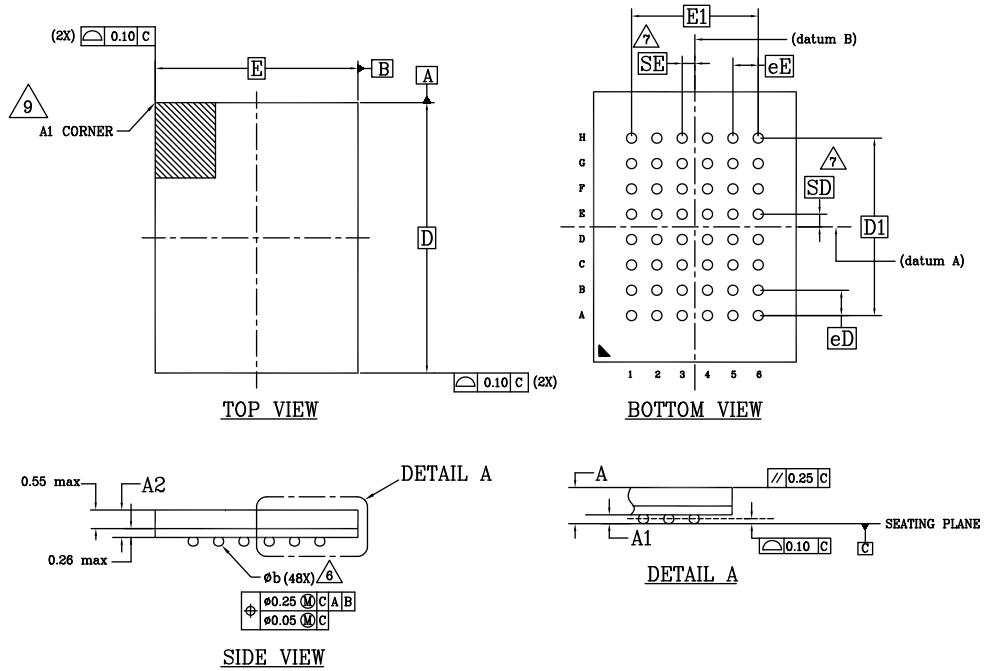
速度 (ns)	电压范围	订购代码	封装图	封装类型 (所有封装都无铅)	主要特性 / 区分点	ERR 引脚 / 球形焊盘	工作范围		
45	2.2 V 至 3.6 V	CY62167GE30-45BV1XI	51-85150	48 ball VFBGA	单芯片使能	有	工业级		
		CY62167GE30-45BV1XIT							
		CY62167GE30-45BVXI			双芯片使能	有			
		CY62167GE30-45BVXIT							
		CY62167G30-45BVXI			无				
		CY62167G30-45BVXIT							
		CY62167GE30-45ZXI			51-85183	48 pin TSOP I		双芯片使能	有
		CY62167GE30-45ZXIT							
	CY62167G30-45ZXI	无							
	CY62167G30-45ZXIT								
	4.5 V 至 5.5 V	CY62167G-45BVXI	51-85150	48 ball VFBGA	双芯片使能	无			
		CY62167G-45BVXIT							
		CY62167G-45ZXI	51-85183	48 pin TSOP I	双芯片使能	无			
		CY62167G-45ZXIT							
CY62167GE-45ZXI		有							
CY62167GE-45ZXIT									
55	1.65 V 至 2.2 V	CY62167GE18-55BVXI	51-85150	48 ball VFBGA	双芯片使能	有			
		CY62167GE18-55BVXIT							
		CY62167G18-55BVXI			无				
		CY62167G18-55BVXIT							
		CY62167G18-55ZXI	51-85183	48 pin TSOP I	无				
		CY62167G18-55ZXIT							

订购代码定义



封装图

图 15. 48 ball VFBGA (6 × 8 × 1.0 mm) 封装外形, 51-85150



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	1.00
A1	0,16	-	-
A2	-	-	0,81
D	8,00 BSC		
E	6,00 BSC		
D1	5,25 BSC		
E1	3,75 BSC		
MD	8		
ME	6		
n	48		
ϕb	0,25	0,30	0,35
eE	0,75 BSC		
eD	0,75 BSC		
SD	0,375 BSC		
SE	0,375 BSC		

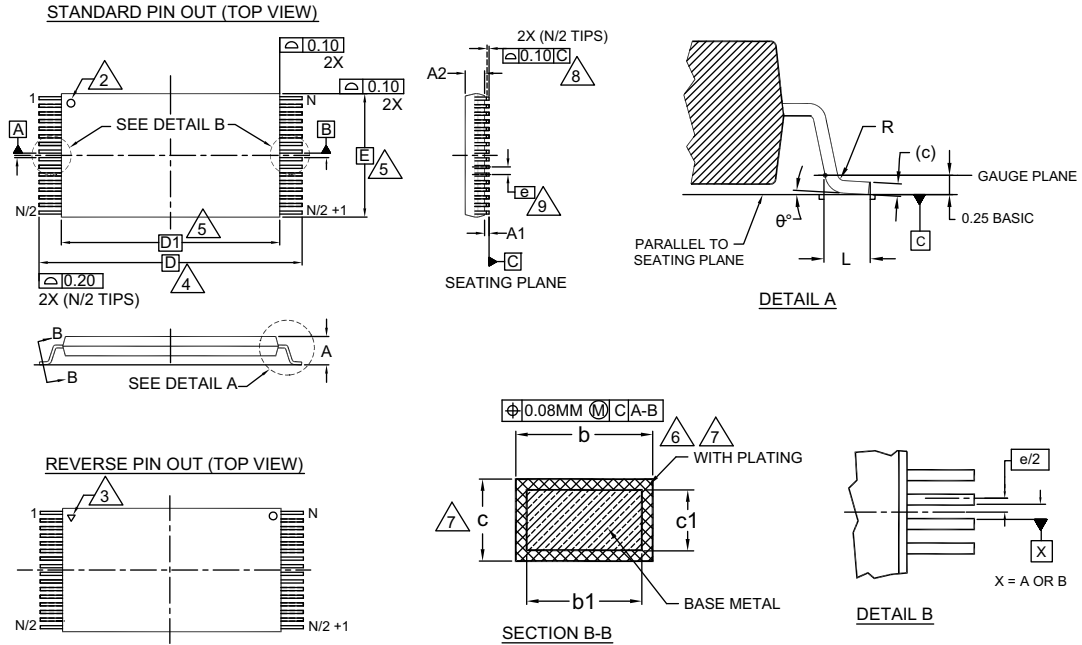
NOTES:

- DIMENSIONING AND TOLERANCING METHODS PER ASME Y14.5M-2009.
- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- BALL POSITION DESIGNATION PER JEP95, SECTION 3, SPP-020.
- ☐ REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.
- SYMBOL "MD" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION. SYMBOL "ME" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION. n IS THE NUMBER OF POPULATED SOLDER BALL POSITIONS FOR MATRIX SIZE MD X ME.
6. DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.
7. "SD" AND "SE" ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW. WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW "SD" OR "SE" = 0. WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" = eD/2 AND "SE" = eE/2.
- ** INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED BALLS.
9. A1 CORNER TO BE IDENTIFIED BY CHAMFER, LASER OR INK MARK METALIZED MARK, INDENTATION OR OTHER MEANS.

51-85150 *I

封装图 (续)

图 16. 48 pin TSOP I (18.4 × 12 × 1.2 mm) 封装外形, 51-85183



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	—	—	1.20
A1	0.05	—	0.15
A2	0.95	1.00	1.05
b1	0.17	0.20	0.23
b	0.17	0.22	0.27
c1	0.10	—	0.16
c	0.10	—	0.21
D	20.00 BASIC		
D1	18.40 BASIC		
E	12.00 BASIC		
e	0.50 BASIC		
L	0.50	0.60	0.70
θ	0°	—	8
R	0.08	—	0.20
N	48		

NOTES:

1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (mm).
2. PIN 1 IDENTIFIER FOR STANDARD PIN OUT (DIE UP).
3. PIN 1 IDENTIFIER FOR REVERSE PIN OUT (DIE DOWN); INK OR LASER MARK.
4. TO BE DETERMINED AT THE SEATING PLANE [C]. THE SEATING PLANE IS DEFINED AS THE PLANE OF CONTACT THAT IS MADE WHEN THE PACKAGE LEADS ARE ALLOWED TO REST FREELY ON A FLAT HORIZONTAL SURFACE.
5. DIMENSIONS D1 AND E DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE MOLD PROTRUSION ON E IS 0.15mm PER SIDE AND ON D1 IS 0.25mm PER SIDE.
6. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08mm TOTAL IN EXCESS OF b DIMENSION AT MAX. MATERIAL CONDITION. DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON LOWER RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE BETWEEN PROTRUSION AND AN ADJACENT LEAD TO BE 0.07mm.
7. THESE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10mm AND 0.25mm FROM THE LEAD TIP.
8. LEAD COPLANARITY SHALL BE WITHIN 0.10mm AS MEASURED FROM THE SEATING PLANE.
9. DIMENSION "e" IS MEASURED AT THE CENTERLINE OF THE LEADS.
10. JEDEC SPECIFICATION NO. REF: MO-142(D)DD.

51-85183 *F

缩略语

缩略语	说明
BHE	字节高电平使能
$\overline{\text{BLE}}$	字节低电平使能
$\overline{\text{CE}}$	芯片使能
CMOS	互补金属氧化物半导体
I/O	输入 / 输出
$\overline{\text{OE}}$	输出使能
SRAM	静态随机存取存储器
TSOP	薄小型封装
VFBGA	细间距球栅阵列
$\overline{\text{WE}}$	写入使能

文档规范
测量单位

符号	测量单位
°C	摄氏度
MHz	兆赫兹
μA	微安
μs	微秒
mA	毫安
mm	毫米
ns	纳秒
Ω	欧姆
%	百分比
pF	皮法
V	伏特
W	瓦特

文档修订记录页

文档标题: CY62167G/CY62167GE MoBL, 带纠错码 (ECC) 的 16 Mbit (1 M 字 × 16 位 / 2 M 字 × 8 位) 静态 RAM			
文档编号: 001-92006			
修订版本	ECN 编号	提交日期	变更说明
**	4335634	04/07/2014	本档版本号为 Rev**, 译自英文版 001-81537 Rev*A。
*A	4471856	08/14/2014	本档版本号为 Rev*A, 译自英文版 001-81537 Rev*G。
*B	5693971	04/21/2017	本档版本号为 Rev*B, 译自英文版 001-81537 Rev*O。
*C	6719650	10/31/2019	本档版本号为 Rev. *C, 译自英文版 001-81537 Rev. *Q。